

<http://physicsworld.com/cws/article/news/30935>

2007/08/23

اولین اسپین‌فت سیلیسیمی

یک گروه پژوهش‌گر برا ی اولین بار یک ترانزیستور اثربخش میدان (اسپین‌فت) [1] از جنس سیلیسیم ساخته‌اند. دو سال پیش هم یک اسپین‌فت ساخته شده بود، اما با یک نانولوله ی کربنی. برتری ی این ابزار، اخیر آن است که براساس سیلیسیم است (که پایه ی الکترونیک تجارتی است) و به این ترتیب گام مهمی به سوی ساختن ابزارها ی اسپین‌ترونیکی ی تجارتی برداشته شده [2]. در ابزارها ی اسپین‌ترونیکی علاوه بر بار الکtron اسپین آن هم به کار می‌رود.

اساس این ابزار آن است که جریان ی از الکترون‌ها ی با اسپین بالا وارد می‌شود. به مجموعه یک میدان مغناطیسی اعمال می‌شود که اسپین الکترون‌ها را می‌چرخاند. در خروجی فقط بخشی از جریان آشکار می‌شود که اسپین الکترون‌ها یعنی بالا است. اگر یک میدان الکتریکی اعمال شود الکترون‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند و در نتیجه مدت کمتری در میدان مغناطیسی می‌مانند و اسپین‌شان کمتر عوض می‌شود. پس هر چه این میدان بزرگ‌تر باشد جریان خروجی بیش‌تر می‌شود. این گروه توانسته با تغییر ولتاژ از صفر تا 3 V جریان خروجی را هفت برابر کند. فعلاً مشکل این است که این ابزار براساس ترابرد بالیستیکی ی الکترون‌ها از درون لایه‌ها ی نازک مغناطیسی است، که جریان خروجی را به مقدارها ی بسیار کوچک از مرتبه ی چندده پیکوآمپر محدود می‌کند. ضمناً این ابزار باید در دما ی کم ی (حدوداً 85 K) کار کند.

[1] spin field-effect transistor (spinFET)

[2] Applied Physics Letters **91** 072501